ленным взаимодействием, где эти ускорения ограничены. Поэтому в теории и расчетах таких приборов возможно использование преобразования Лоренца в расчетах сил пространственного заряда.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. М., 1955. [2] Кураев А. А., Синицын А. К.//Радиотехн. и электроника. 1989. 34, № 10. С. 2166. [3] Кураев А. А., Синицын А. К., Тимохин А.//ДАН БССР. 1989. 33, № 11. С. 989. [4] Вайнштейн Л. А., Солнцев В. А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике. М., 1973.

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1992. Т. 33, № 3

УДК 621.385.653

ЭФФЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ И СВЕРХИЗЛУЧЕНИЯ В АНСАМБЛЯХ ЭЛЕКТРОНОВ-ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Н. С. Гинзбург, А. С. Сергеев *)

Исследовано индуцированное излучение локализованных ансамблей электроновосцияляторов в свободном пространстве. Эффекты канализации реализуются при распространении волновых пучков вдоль электронных потоков, играющих роль открытых активных волноводов. На линейной стадии взаимодействия возбуждаются квазиповерхностные моды, а на нелинейной — волновой пучок расширяется и электромагнитная энергия излучается во внешнее пространство. Происходит стохастическое торможение частиц, взаимодействующих с ансамблем электромагнитных волн, распространяющихся под различными углами к оси системы, и КПД может быть выше, чем в закрытых волноводах. Эффекты сверхизлучения имеют место в сгустках электронов-осцилляторов, формирующих движущиеся активные резонаторы. Вследствие развития беспороговой неустойчивости возникает банчировка электронов и их когерентное излучение, которое будет квазимонохроматическим в сопровождающей системе отсчета и многочастотным — в лабораторной. Если поступательная скорость сгустка близка к скорости света, то основная доля мощности излучения сосредоточена в коротковолновой компоненте.

1. Введение

В соответствии с соотношениями Крамерса—Кронига восприимчивость ансамблей электронов-осцилляторов имеет как активную, так и реактивную составляющие. Поэтому при локализации в свободном пространстве такие осцилляторы могут не только усиливать электромагнитное излучение, но и формировать электронные волноводы и резонаторы, определяющие пространственно-временную структуру излучения. Настоящий обзор посвящен двум основным типам радиационных процессов в локализованных ансамблях электронов-осцилляторов канализации и сверхизлучению.

Эффекты канализации [1—19] реализуются при распространении и усилении излучения вдоль электронных волноводов, формируемых интенсивными электронными пучками. Эффекты канализации могут быть полезны при исследовании:

а) селекции мод по поперечному индексу в устройствах с пространственно-развитыми электродинамическими системами, в частности когерентного излучения на «горячих модах», представляющих собой сумму большого числа мод холодной электродинамической системы;

б) увеличения инкрементов нарастания и снижения стартовых токов, обусловленных концентрацией излучения в области электронного

^{*)} Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород.

пучка, и уменьшения полного объема, занимаемого электромагнитным полем;

в) уменьшения опасности ВЧ-пробоев вследствие уменьшения напряженностей полей на стенках электродинамических систем;

г) увеличения эффективности энергообмена.

В данной работе эффекты канализации исследованы на примере двумерной модели лазера на свободных электронах (ЛСЭ) с ленточным электронным пучком. Показано, что на линейной стадии взаимодействия имеет место возбуждение квазиповерхностных усиливающихся мод. На нелинейной стадии волновой пучок расширяется и электромагнитная энергия излучается во внешнее пространство. Этот процесс сопровождается стохастическим торможением частиц, взаимодействующих с ансамблем волн, распространяющихся под различными углами к оси системы. В результате может достигаться эффективность энергообмена, значительно превышающая имеющую место в традиционных условиях, когда поперечная структура поля (фактически угол излучения) задается внешними электродинамическими системами.

Эффекты сверхизлучения [19—31] развиваются в электронных сгустках, формирующих активные электронные резонаторы (с размерами, вообще говоря, превышающими длину волны). В результате развития беспороговых сверхизлучательных неустойчивостей энергия осцилляторного движения может излучаться в виде коротких электромагнитных импульсов. Подобные процессы следует рассматривать как классический аналог известного в квантовой электронике эффекта сверхизлучения Дикке [32-34]. Если электронный сгусток движется поступательно, то в соответствии с эффектом Доплера частота излучения в лабораторной системе отсчета будет зависеть от угла наблюдения, примерно совпадая с частотой индивидуального излучения осциллирующей частицы. Таким образом, рассматриваемое излучение обладает свойствами как индуцированных (когерентность), так и спонтанных процессов (разнонаправленность, многочастотность, беспороговость). Заметим, однако, что при поступательной скорости сгустка, близкой к скорости света, основная доля излучаемой мощности окажется сосредоточенной в коротковолновой компоненте, распространяющейся в направлении поступательного движения. Ниже сверхизлучательные неустойчивости исследованы для сгустка (слоя) электронов, вращающихся в однородном магнитном поле, а также для электронного сгустка, движущегося в поле ондулятора.

2. Эффекты канализации

а) Основные уравнения. Рассмотрим двумерную модель ЛСЭ (рис. 1). Предположим, что осцилляторное движение сообщается электронам при движении в поле плоского ондулятора, магнитное поле которого задается вектор-потенциалом

$$\mathbf{A}_{u} = \operatorname{Re}\left[\mathbf{y}_{0}A_{u}\operatorname{ch}\left(h_{u}x\right)\exp\left\{ih_{u}z\right\}\right],\tag{1}$$

где $h_{\mu}=2\pi/d$, d — период ондулятора. Ленточный релятивистский электронный пучок инжектируется в плоскости x=0, поступательная скорость частиц $v_{\parallel}=\beta_{\parallel}c$ направлена вдоль оси z. Пусть излучаемое электромагнитное поле представляет собой монохроматический квазиоптический волновой пучок, распространяющийся вдоль оси системы:

$$\mathbf{A}_{s} = \operatorname{Re}\left[y_{0}A_{s}\left(z, x\right)\exp\left\{i\left(\omega_{s}t-h_{s}z\right)\right\}\right].$$
(2)

При выполнении условий комбинационного синхронизма $\omega_s = h_c \sigma_{\parallel}$ $(h_c = h_s + h_u, h_s = \omega_s/c)$ процесс стимулированного излучения описывается системой усредненных уравнений движения электронов и параболическим уравнением для амплитуды волнового пучка. В предположении, что относительные изменения энергии электронов невелики, а также в пренебрежении куло-

новским взаимодействием частиц самосогласованная система уравнений может быть приведена к виду

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial Z^2} = \operatorname{Im} \left(a \exp \left\{ i\theta \right\} \right), \quad (3)$$
$$i \frac{\partial^2 a}{\partial X^2} + \frac{\partial a}{\partial Z} = 2i\delta \left(X \right) j \quad (4)$$



Рис. 1. Двумерная модель ЛСЭ с плоским ондулятором и ленточным электронным пучком

с граничными условиями

$$\theta|_{Z=0} = \theta_0 \in [0, \ 2\pi], \ \frac{\partial \theta}{\partial Z}\Big|_{Z=0} = -\Delta, \ a|_{Z=0} = a_0(X).$$
(5)

При записи (3)—(5) использованы следующие безразмерные обозначения: $Z = (\omega_s/c) zG$, $X = (\omega_s/c) x \sqrt{2G}$ — продольная и поперечная координаты, $\theta = \omega_s t - h_c z$ —фаза электрона относительно комбинационной волны, $j = (1/\pi) \int_0^\infty \exp\{-i\theta\} d\theta_0$ —амплитуда первой гармоники высокочастотного тока, $a = \mu \alpha_s \alpha_u G^{-2}/2$ —амплитуда волны, $\mu = \gamma_0^{-2} \beta_{\parallel 0}^{-3}$, $\alpha_{s,u} = eA_{s,u'}(mc^2 \gamma_0)$, $\Delta = (c/v_c^{\min} - c/v_{\parallel 0}) G^{-1}$ —начальная расстройка комбинационного синхронизма, $v_c^{\min} = \omega_s/h_c$ —фазовая скорость комбинационной волны, которая соответствует электромагнитной волне, излучающейся строго вдоль оси системы,

$$G = (1/2^{1/5}) \left(\mu \alpha_{\mu}^2 \omega_{p\perp}^2 b / (8 \omega_s c \beta_{\parallel}^2) \right)^{2/5}$$
(6)

—параметр усиления, $\omega_{p\perp} = \sqrt{4\pi e^2 \rho_0/(m\gamma_0)}$ —«поперечная» плазменная частота, $\gamma_0 = (1 - \beta_{\parallel 0}^2)^{-1/2}$, *b*— ширина электронного пучка, $\delta(X)$ — дельта-функция. Мы исследуем здесь случай тонкого ленточного электронного пучка, которому соответствует малый параметр Френеля: $b^2/L\lambda \ll 1$, где L— характерная длина взаимодействия (обратный инкремент), λ — длина волны излучения.

Из уравнений (3) — (5) следует закон сохранения энергии

$$\frac{dP}{dZ} = 8 \frac{d\hat{\eta}}{dZ} = 4|a||_{X=0}|j|\sin\varphi,$$
(7)

где
$$P = \int_{2\pi}^{\infty} |a|^2 dX$$
 продольный поток электромагнитной энергии, $\widehat{\eta} = (1/2\pi) \int_{0}^{2\pi} u \, d\theta_0$ приведенный КПД (полный КПД $\eta = \frac{G}{\mu (1 - \gamma_0^{-1})} \widehat{\eta}$),
 $u = \partial \theta / \partial Z + \Delta$ нормализованные потери энергии электронов, $\varphi = \arg a |_{X=0}$ агд j анд j не μ на \mathfrak{g} с та дия взан модей ствия. Режим кана-

 б) Линейная стадия взаимодействия. Режим канализации излучения электронным потоком. В приближении малого сигнала $(a \rightarrow 0)$, линеаризуя уравнения движения (3), получим уравнение для амплитуды ВЧ тока:

$$\left(\frac{\partial}{\partial Z}-i\Delta\right)^2 j=-a. \tag{8}$$

Для безграничной в продольном направлении системы, представляя решение уравнений (4), (8) в виде $j=\hat{j}\exp\{i\Gamma Z\}$, $a=\hat{a}\exp\{i\Gamma Z-i\varkappa|X|\}$, получаем дисперсионное уравнение, описывающее нормальные волны [10]:

$$\varkappa (\varkappa^2 - \Delta) = i, \qquad [(9)]$$

где и $\Gamma = \kappa^2$ — поперечные и продольные волновые числа. Корни дисперсионного уравнения (9) легко находятся в случае точного синхронизма:

$$\kappa_n = \exp\{i(\pi/10 + 2\pi (n-1)/5)\}, \ \Gamma_n = \exp\{i(\pi/5 + 4\pi (n-11/5))\}, \ (10)$$

где n=1, ..., 5. Таким образом, в рассматриваемой системе существуют пять нормальных волн (рис. 2). Однако среди этих волн только одна



Рис. 2. Расположение на комплексной плоскости поперечных (a) и продольных (б) волновых чисел нормальных воли ленточного потока электронов-осцилляторов. Стрелками показано направление смещения корня, соответствующего усиливающейся локализованной моде n=5 при изменении параметра расстройки синхронизма Δ

волна (n=5) усиливается в продольном направлении (Im $\Gamma_5 < 0$), спадает в поперечном (Im $\kappa_5 < 0$) и имеет поток электромагнитной энергии, направленной от электронного пучка к периферии (Re $\kappa_5 > 0$).

На рис. З показаны продольные и поперечные волновые числа канализируемой моды (n=5) при произвольных значениях параметра расстройки Δ . Максимальный инкремент достигается при $\Delta=0$. Фазовая скорость электромагнитной волны $v_{\rm ph}=\omega_s/c(1-{\rm Re}\,\Gamma)$ меньше, чем скорость света c, в области $\Delta<0,4$ и превышает эту скорость в области $\Delta>0,4$.

Согласно рис. 3, *a*, чем больше параметр Δ , т. е. чем больше разница между поступательной скоростью электронов $v_{\parallel 0}$ и минимальной фазовой скоростью комбинационной волны v_c^{\min} , тем больше реальная часть поперечного волнового числа и меньше мнимая часть. Это оз-

начает, что с ростом ∆ возрастает поперечный поток электромагнитной энергии и уменьшается степень локализации волнового пучка вблизи электронного канала. В асимптотическом случае ∆≫1 имеем

Re
$$\varkappa = \Delta^{1/2}$$
, Im $\varkappa = \frac{1}{2\sqrt{2}}\Delta^{-3/4}$, Re $\Gamma = \Delta$,
Im $\Gamma = \frac{\Delta^{-1/4}}{\sqrt{2}}$. (11)

В этом случае собственная мода представляет собой сумму двух плоских волн, излучающихся под таким углом ψ к оси системы, что фазовая скорость комбинационной волны

$$v_c(\psi) = \frac{\omega_s}{h_\mu + (\omega_s/c)\cos\psi} \tag{12}$$

совпадает с поступательной скоростью электронов. Канализационные эффекты в этом режиме почти несущественны. Напротив, в области больших отрицательных Δ

> Рис. 3. Зависимость от параметра расстройки синхронизма действительных и мнимых частей поперечных (а) и продольных (б) волновых чисел усиливающейся локализованной моды



поперечный поток электромагнитной энергии стремится к нулю (Re ∞→→0), масштаб локализации поля уменьшается и взаимодействие приобретает чисто реактивный характер.

На основе линейной системы уравнений (4), (8) можно рассмотреть полубезграничную задачу о дифракции плоской волны: $a_0(X) =$ =const, падающей на слой электронов-осцилляторов в сечении Z=0. Используя преобразование Лапласа, для излучаемого поля при $\Delta=0$ получим [11]

$$a(Z, X) = a_0 \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{i} X}{2\sqrt{Z}}\right) + \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{5} \exp\left\{-i\varkappa_n |X| + i\Gamma_n Z\right\} \times \left(1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{i} X}{2\sqrt{Z}} - \varkappa_n \sqrt{iZ}\right)\right) \right],$$
(13)

где величины \varkappa_n , Γ_n определяются соотношениями (10), $\Phi(u)$ — интеграл вероятности. Принимая во внимание асимптотические представления функции $\Phi(u)$ при больших значениях аргумента, из (12) получим, что пространственная структура поля в зоне, удаленной от входного сечения на расстояние, существенно превосходящее обратный инкремент $Z\gg1$, определяется возбуждением канализируемой усиливаемой волны:

$$a(Z, X) \rightarrow (2/5) a_0 \exp\{-i\kappa_5 |X| + i\Gamma_5 Z\}.$$
(14)

в) Нелинейная стадия взаимодействия. Режим дифракционного излучения электронного потока во внешнее пространство. Исследование нелинейной стадии взаимодействия ленточного потока электронов-осцилляторов с волновым пучком проводилось в [11—13] путем численного моделирования уравнений движения электронов (3) совместно с интегральным представлением решения параболического уравнения:

$$a(Z, X) = \frac{\sqrt{i}}{2\sqrt{\pi Z}} \int_{-\infty}^{\infty} a_0(X) \exp\left\{-\frac{i(X-X')^2}{4Z}\right\} dX' - \frac{1}{\sqrt{i\pi}} \int_{0}^{Z} \exp\left\{-\frac{iX^2}{4(Z-Z')}\right\} / \sqrt{Z-Z'} dZ'.$$
(15)

Предполагалось, что падающее поле представляет собой гауссов пучок: $a_0(X) = a_0 \exp \{-X^2/\bar{X}^2\}$. На рис. 4, 5 представлены результаты численного моделирования при $\Delta = 0$ и $\Delta = 6$. Численное моделирование подтвердило сделанный выше вывод, что при произвольном начальном про-



Рис. 4. Профиль волнового пучка (a); угловой спектр (б); амплитуда ВЧ-поля, действующего на электроны, амплитуда ВЧ-тока и приведенный КПД (в); разностная фаза (г); относительные потери энергии частиц (д) как функции продольной координаты при Δ=0



Рис. 5. То же, что на рнс. 4, при $\Delta=6$

филе волнового пучка в области линейного усиления на достаточном удалении от входного сечения (на рис. 4, $a, \delta Z \simeq 5$, на рис. 5, $a, \delta Z \simeq 210$) структура и угловой спектр

$$S_{\varkappa} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} a(X) \exp\{-i\kappa X\} dX$$

излучаемого поля близки к структуре собственной локализованной моды. При этом, согласно результатам п. 2 б, имеет место частичное вытекание электромагнитной энергии из электронного канала. Это вытекание приводит к тому, что в области (Z>5 на рис. 4, Z>10 на рис. 5), где начинают играть роль эффекты насыщения и амплитуда поля в приосевой зоне стабилизируется (см. рис. 4, в и 5, в), возникает расширение поперечных размеров волнового пучка (на периферию приходят лучи, испущенные электронами в предшествующих сечениях). На нелинейной стадии существует достаточно протяженная область высвечивания генерируемой электронным потоком электромагнитной энергии во внешнее пространство.

На конечном участке (Z>40 на рис. 4 и Z>100 на рис. 5) взаимодействие электронов с волновым пучком приобретает чисто реактивный характер: устанавливается стационарное солитоноподобное состояние, когда захваченные волной электроны создают ВЧ ток, амплитуда которого вследствие сильного перемешивания частиц внутри фазового объема, ограниченного сепаратрисой, постоянна, а фаза тока по отношению к фазе поля близка к π (рис. 4, *г*, 5, *г*), т. е. энергообмен отсутствует (см. (7)). При этом небольшая доля излученной энергии про-



должает канализироваться электронным потоком благодаря эффекту полного внутреннего отражения.

Важно отметить, что при излучении потока осцилляторов в свободном пространстве КПД монотонно растет (в рамках сде-

Рис. 6. Зависимость максимального приведенного КПД от начальной расстройки синхронизма

ланных при выводе уравнений движения предположений) *) с увеличением параметра начального рассинхронизма (рис. 6).

Рост КПД обусловлен эффектом стохастического торможения частиц (ср. с [35]), существенном при больших положительных значениях параметра Δ (см. рис. 5, ∂ , область 15< Z < 100). Дело в том, что излучаемое в свободное пространство поле представляет собой совокупность плоских волн, распространяющихся под различными углами ф к оси системы, которым соответствуют различные скорости синхронных с электронами комбинационных волн (см. (12)). При этом если на линейной стадии (см. рис. 5, б) в угловом спектре излучения при ∆≫1 спектральные максимумы ($\varkappa \simeq \sqrt{\Delta}$, ср. с (11)) соответствуют волнам, излучающимся под такими углами ψ , что фазовая скорость комбинационных волн близка к невозмущенной поступательной скорости частиц $v_{c}(\psi) = v_{\parallel 0}$, то по мере торможения частиц происходит заполнение спектра волнами, излучающимися под меньшими углами ф, для которых $v_c(\psi) < v_{\parallel c}$. Наиболее медленная компонента пакета комбинационных волн $v_c^{\min} = \omega_s / h_c$, очевидно, соответствует электромагнитной волне, распространяющейся строго вдоль оси системы: ψ→0. Как видно из рис. 5, д, электроны последовательно (эстафетно) взаимодействуют с различными компонентами пакета комбинационных волн, пока средняя скорость v_{II} всех электронов не сравняется с v_c^{min}, далее энергообмен практически прекращается. Электронный КПД при этом оказывается тем выше, чем сильнее начальная поступательная скорость частиц $v_{\parallel 0}$ превосходит v_c^{\min} , т. е. чем больше параметр Δ .

Анализ полных уравнений движения (т. е. уравнений, в которых не предполагается малости изменения энергии частиц) показывает, что в режиме излучения в свободное пространство в ЛСЭ может достигаться КПД, превышающий 50% [13]. Такой уровень КПД сравним со значениями, реализующимися в ЛСЭ с ондуляторами переменного периода [37]. Однако в рассматриваемой здесь ситуации, в отличие от [37], излучение имеет сложный угловой спектр, что, естественно, затрудняет его практическое использование.

^{*)} При тех же предположениях в системах с фиксированной поперечной структурой поля максимум приведенного КПД $\widehat{\eta}$ =2,56 достигается при Δ =1,78 [36], а при больших Δ происходит срыв режима усиления.

Заметим в заключение, что магнитотормозное излучение поливинтового электронного потока в однородном магнитном поле [14, 19] или черенковское излучение прямолинейного ленточного электронного пучка в однородной диэлектрической среде [15] или плазме [16—18] имеют характеристики, аналогичные описанным выше. То есть имеет место канализация излучения на линейной стадии взаимодействия и расширение волнового пучка, сопровождающееся режимом стохастического торможения частиц на нелинейной стадии.

3. Эффекты сверхизлучения

Рассмотрим здесь процессы индуцированного излучения в ансамблях осцилляторов, образующих активные электронные резонаторы. Особенностью исследуемых далее вопросов по сравнению с традиционными для электроники СВЧ постановками генераторных задач является «непролетность», т. е. бесконечно большое время жизни и взаимодействия осцилляторов с высокочастотным полем *). При этом электронный сгусток (резонатор) может двигаться как целое. Ниже в рамках одномерной модели исследуются особенности циклотронного и ондуляторного сверхизлучений.

а) Циклотронное сверхизлучение. Допустим, что электроны, вращающиеся в однородном магнитном поле $\mathbf{H}=H_0\mathbf{z}_0$, образуют слой, который безграничен в *x*, *y*-направлениях и имеет ширину *b* вдоль оси *z*. Электроны имеют одинаковый поперечный импульс $p_{\perp 0}=m_{\mathbf{Y}}v_{\perp 0}$ и с точностью до малых флуктуаций равномерно распределены по фазам циклотронного вращения. Поступательная скорость у электронов отсутствует.

Движение электронов описывается следующим уравнением:

$$\frac{\partial p_{+}}{\partial t} - i\omega_{H}p_{+} = -eE_{+}(z, t), \tag{16}$$

где $p_+=p_x+ip_y$, $E_+=E_x+iE_y$, $\omega_H=eH_0/mc\gamma$ — релятивистская гирочастота, $\gamma=(1+|p_+|^2/m^2c^2)^{\frac{1}{2}}$. Слой будет излучать в $\pm z$ -направлении циркулярно поляризованные волны. Амплитуда поля определяется вынужденным решением волнового уравнения

$$E_{+} = (-2\pi/c) \int_{z-ct}^{z+ct} j_{+}(z', t-|z-z'|/c) dz', \qquad (17)$$

где $j_{+}=e_{p_{0}}\langle v_{+}\rangle$ — плотность электронного тока, $v_{+}=v_{x}+iv_{y}$, $\langle ...\rangle$ — знак усреднения по фазам циклотронного вращения.

Предположим для определенности, что электроны слаборелятивистские: $\gamma \simeq 1 + |p_+|^2/(2m^2c^2)$ и спектр излучения сосредоточен вблизи нерелятивистской гирочастоты $\omega_{H_q} = eH_0/mc$. Соответственно, представляя поле излучения и импульс электронов в виде $E_+ = A(z, t) \exp \{i\omega_{H_0}t\}$, $p_+ = p \exp \{i\omega_{H_0}t\}$, приведем систему уравнений (16), (17) к виду **) [27, 28]

^{*)} На практике достаточно, чтобы время жизни превосходило обратные инкременты и время высвечивания энергии.

^{**)} Заметим, что система уравнений (18), (19) носит достаточно универсальный характер и описывает сверхизлучение в слоях неизохронных осцилляторов разлёчной физической природы, включая акустические осцилляторы [31].

$$\frac{\partial c^{\mathcal{P}}}{\partial \tau} + i\mu |\mathscr{P}|^{2} \mathscr{D} = a,$$

$$\mathscr{D}|_{\tau=0} = \exp \{i \left(\theta_{0} + r \cos \theta_{0}\right)\}, \quad \theta_{0} \in [0, \ 2\pi],$$

$$a = q \int_{z-\tau}^{z+\tau} f(Z) \left\langle \mathscr{P}(Z', \ \tau - |Z - Z'|) \right\rangle \exp \{-i |Z - Z'|\} \, dZ'.$$
(18)
(19)

Здесь $\tau = \omega_{H_0}t$, $Z = (\omega_{H_0}/c) z$, $\mathcal{P} = p/p_{\perp 0}$, $a = eA/(m\omega_{H_0}v_{\perp 0})$, $q = \omega_p^2/(2\omega_{H_0}^2)$, $\mu = v_{\perp 0}^2/2c^2$ — параметр неизохронности; $r \ll 1$ — параметр, характеризующий начальную модуляцию по фазам циклотронного вращения; f(Z) — функция, описывающая распределение плотности осцилляторов вдоль слоя. Далее рассматривается однородное распределение:

 $f(Z) = \text{const}, Z \in [-B/2, B/2], B = (\omega_{H_0}/c) b_{\bullet}$

В приближении слабого сигнала после линеаризации уравнений движения получим характеристическое уравнение, определяющее частоты и пространственные структуры собственных мод:

$$\exp\left\{2ih_iB\right\} = \left(\frac{h_e - h_i}{h_e + h_i}\right)^2. \tag{20}$$

Здесь h_{e,i} — нормализованные волновые числа вне и внутри слоя:

$$h_e = (-\mu + \Omega + 1), \ h_i = (h_e^2 + 2qh_e(-\Omega + \mu)/\Omega^2)^{1/2}.$$
 (21)

. ...

В случае тонкого слоя ($B \ll 1$) из уравнений (20), (21) получаем [20, 23, 25]

$$\Omega^2 - iqB\Omega + i\mu qB = 0. \tag{22}$$

Для малой плотности q << 1 для инкремента неустойчивости имеем

$$|\operatorname{Im}\Omega| = \sqrt{qB\mu/2}.$$
(23)

Для произвольной ширины слоя инкременты первой симметричной S_1 и первой антисимметричной A_1 мод представлены на рис. 7, а. Максимальный инкремент имеет первая симметричная мода (при $B \ll 1$ ее инкремент определяется соотношением (23)). Инкременты других мод приближаются к инкременту основной симметричной моды по мере увеличения ширины слоя. Рис. 7, б иллюстрирует пространственные структуры мод.

Нелинейная стадия циклотронного сверхизлучения может быть исследована с помощью численного решения уравнений (18), (19). На рис. 8 приведены временные зависимости мощности излучения В/2

$$P = |a|^2 |_{Z=\pm B/2}$$
 и электронного КПД $\eta = 1 - 1/B \int_{-B/2} \langle |\mathcal{P}|^2 \rangle dZ$. Заме-

тим, что пиковая мощность и длительность цуга импульсов увеличиваются по мере роста толщины слоя. Рис. 9 демонстрирует формирование пространственного распределения поля, совпадающего со структурой первой симметричной моды на начальной линейной стадии неустойчивости, $\tau < 60$, и усложнение (стохастизацию) этой структуры на нелинейной стадии, $\tau > 60$.

Оценим численно пиковую мощность сверхизлучения и длительность импульса. Пусть напряженность магнитного поля составляет

100 кЭ, частота излучения $\omega = 2 \cdot 10^{12} \text{ c}^{-1}$ ($\lambda = 1$ мм), плотность электронов $\rho_0 = 2 \cdot 10^{14}$ см⁻³, поперечная скорость $v_{\perp 0} = 0.45$ с, ширина слоя $b \simeq$ ≈2 λ. При таких значениях параметров q=0,1, µ=0,1 и мощность, из-



Рис. 7. Инкременты первой снмметричной S_1 и первой антисим-метричной A_1 мод как функции ширины слоя (а). Пространственная структура мод при B=6, $\mu=$ =0,1, q=0,1 (6)

достигать 1,5 ГВт. Длительность значения составляет 1,5 · 10-11 с.

Заметим, что можно существенно увеличить мощность излучения и сдвинуть частоту в коротковолновую часть спектра, придав слою поступательную скорость, близкую к скорости света [25].

б) Сверхизлучение электронного сгустка, движущегося в периодическом магнитном поле. Рассмотрим излучение короткого электронного сгустка, движущегося в поле ондулято-Допустим, pa. что размер электронного сгустка велик в масштабе длины волны излучения, но мал в масштабе ДЛИНЫ ондулятора, так что

время жизни электронов в ондуляторном поле (в отличие от ситуации, традиционно исследуемой в теории ЛСЭ) можно считать бесконечным.

Исследуем здесь нелинейную стадию эффекта сверхизлучения в рамках одномерной модели (линейный анализ см. в [24, 19]). Предположим, что сгусток представляет собой слой ширины b в z-направле-



Рис, 8. Мощность циклотронного сверхизлучения и электронный КПД (пунктир) как функции времени при B=6, $\mu=0,1, q=0,1$

лучаемая с одного квадратного сантиметра поверхности слоя, может импульса на уровне 1/е от пикового



Рис. 9. Эволюция пространственного распре-

деления поля внутри слоя осцилляторов при

 $B=6, \mu=0,1, q=0,1$

нии и безграничен в поперечном направлении. Рассмотрение проведем в сопровождающей системе К', где поле ондулятора трансформируется в поле электромагнитной волны накачки, заданной вектор-потенциалом

$$\mathbf{A}'_{u} = \operatorname{Re}\left[\mathbf{y}_{0} \mathbf{A}'_{u} \exp\left\{i\left(\omega_{u} t' - h'_{u} z'\right)\right\}\right],\tag{24}$$

где $h'_{u} = \gamma h_{u}$, $\omega'_{u} = \gamma c h_{u}$, $h_{u} = 2\pi/d$, d— период ондулятора, $\gamma = (1 - v_{\parallel}^{2}/c^{2})^{-1/2}$, v_{\parallel} — поступательная скорость слоя. Накачка сообщает частицам осцилляторную скорость $v'_{y} = \operatorname{Re}\left[\frac{eA'_{u}}{mc}\exp\left\{i\left(\omega'_{u}t' + h'_{u}z'\right)\right\}\right]$. Поле, излучаемое (рассенваемое) осцилляторными частицами, может быть представлено в виде двух волн, бегущих в $\pm z'$ -направлениях:

$$\mathbf{A}'_{s} = \operatorname{Re} \left[\mathbf{y}_{0} A^{'\pm}_{s}(z', t') \exp \left\{ i \left(\omega'_{s} t' \mp h^{'}_{s} z' \right) \right\} \right], \tag{25}$$

где $h'_s = \omega'_s/c$, ω'_s — несущая частота (далее считаем $\omega'_s = \omega'_u$). Совместное воздействие на электроны полей (24), (25) приведет к появлению усредненной пондеромоторной силы, ответственной за банчировку электронов:

$$F'_{\text{pond}} = -\frac{e^2}{4m\omega'_{\mu}^2} \frac{\partial}{\partial z'} \operatorname{Re} \left[A'_{\mu}A'_{s} + \exp \left\{ i \left(h'_{s} + h'_{u} \right) z' \right\} + A'_{\mu}A'_{s} - \exp \left\{ i \left(h'_{s} - h'_{u} \right) z' \right\} \right].$$
(26)

Для численного моделирования процесса сверхизлучения разобьем слой на N_{Σ} плоскостей (макроэлектронов) с координатами $z'_n(t', z'_{0n})$, где z'_{0n} — начальные координаты макроэлектронов. Указанные макроэлектроны взаимодействуют между собой посредством пондеромоторной силы (26) и силы кулоновского расталкивания F'_{Coul} (считаем, что статический заряд электронов скомпенсирован неподвижным ионным фоном). Уравнения движения макроэлектронов в лагранжевых переменных могут быть представлены в виде

$$\frac{d\beta'_n}{d\tau} = F'^n_{\text{pond}} + F'^n_{\text{Coul}}, \quad \frac{dZ'_n}{d\tau} = \beta'_n, \quad (27)$$

где

$$F_{\text{pond}}^{'n} = \frac{q \alpha_u^{'2} B}{8N_{\Sigma}} \left[-\sum_{m}^{N^+(n)} v_+ \cos(Z_n^{'} - Z_m^{'}) + \sum_{m}^{N^-(n)} v_- \cos(Z_n^{'} - Z_m^{'}) \right],$$

$$F_{\text{Coul}}^{'n} = \frac{q B}{2N_{\Sigma}} \left[N^+ - N^- - N_i^+ + N_i^- \right].$$

Начальные условия задавались в виде

$$Z'_{n}|_{\tau=0} = B\left(\frac{n-1}{N_{\Sigma}-1}-\frac{1}{2}\right), \ \beta'_{n}|_{\tau=0} = 0, \ n \in [1, N_{\Sigma}].$$

Здесь $\tau = \omega'_{u}t'$, $Z' = (\omega'_{u}/c)z'$, $v' = \beta'c$ скорость продольных смещений, $q = \omega_{p}^{2}/\omega_{u}^{2}$, $\omega'_{p} = \sqrt{4\pi e^{2}\rho_{0}/m}$, ρ'_{0} плотность слоя, $B = (\omega'_{u}/c)b'$, $\alpha'_{u} = eA_{u}/mc$, $v_{\pm} = (h'_{s} \pm h'_{u})c/\omega'_{u}$, $N^{\pm}(n)$ число электронов с координатами, большими (меньшими), чем Z'_n , $N^{\pm}_i(n)$ то же для компенсирующего ионного фона. Для амплитуд излучаемых электронами волн имеем

$$\alpha_{s}^{'\pm} = \frac{eA_{s}^{'\pm}}{mc^{2}} = \frac{iq\alpha_{u}^{'B}}{4N_{\Sigma}} \sum_{m}^{N^{\mp}} \exp\{-i\nu_{\pm} |Z' - Z_{m}^{'}(\tau)|\}.$$
(28)

На рис. 10 показана зависимость от продольной координаты пондеромоторной силы, с которой один макроэлектрон воздействует на остальные. В отличие от силы кулоновского расталкивания (пунктир)



Рис. 10. Зависимость от продольной координаты пондеромоторной силы, с которой один макроэлектрон воздействует на остальные макроэлектроны. Пунктир — сила кулоновского расталкивания

эта сила в ближней зоне является притягивающей. Такой характер поведения силы взаимодействия должен приводить к неустойчивости и разбиению слоя на когерентно излучающие сгустки, что для начальной стадии процесса ($\tau \simeq 10$, ..., 20) ясно видно из рис. 11, где представле-



Рис. 11. Зависимость от времени координат макроэлектронов при q = = 0.04, $\alpha_u' = 0.77$, $v_{\pm} = 2$, $v_{-} = 0.1$, B = 50

ны зависимости координат электронов от времени. При этом в рассматриваемом случае релятивистского ($\gamma \gg 1$) движения слоя (в лабораторной системе K), когда $h'_s \simeq h'_u$ и $v_+ \gg v_-$ ($v_+ \simeq 2$, $v_- \simeq \gamma^{-2}/2$), определяющее воздействие на движение электронов оказывает компонента пондеромоторной силы, обусловленной волной A'_s , т. е. волной, распространяющейся навстречу волне накачки (в направлении поступательного движения в системе K). Соответственно электроны банчируются таким образом, чтобы обеспечить существенное возрастание амплитуды этой волны по сравнению с начальным моментом времени (рис. 12).



Рис. 12. Амплитуды рассеянных волн $a_{\mu}'|a_{s}'^{\pm}|/2$ на концах слоя как функции времени при q=0,04, $a_{\mu}'=0,77$, $v_{+}=2$, $v_{-}==0,1$, B=50

При идеальной группировке электронов максимальное значение амплитуды этой волны определяется соотношением $|\alpha'_s^+| = q \alpha'_u B/2$. Пиковая амплитуда поля $|\alpha'_s^+|$ на рис. 12 примерно в 2,7 раза меньше этой величины. Таким образом, в определенный момент времени $\tau \simeq 15$ достигается высокая степень когерентности излучения частиц. При больших временах происходит сильное перемешивание частиц внутри слоя и амплитуда волны A'_s^+ падает.

Рассмотрим теперь особенности сверхизлучения в лабораторной системе отсчета. Если в сопровождающей системе частоты волн, излучаемых слоем в $\pm z$ -направлениях, совпадали, то в лабораторной системе при $v_{\parallel} \rightarrow c$ эти частоты будут существенно отличаться: $\omega_{+}/\omega_{-} \simeq 2\gamma^{2}$. Соответственно с учетом закона сохрансния числа квантов получаем, что мощность, излучаемая в положительном направлении оси z, будет существенно превосходить мощность, излучаемую в противоположном направлении:

$$\frac{p^+}{p^-} = \frac{\omega_+}{\omega_-} \frac{p'^+}{p'^-} \simeq 4\gamma^2, \qquad (29)$$

где $P'^{\pm} = |\vec{A}_s^{\pm}|^2 / (8\pi \omega_u^{'2} c)$. Таким образом, в лабораторной системе отсчета основная доля энергии сверхизлучения будет сосредоточена в коротковолновой компоненте и исследованный эффект может рассматриваться как перспективный для получения когерентного излучения, в особенности в диапазонах, в которых отсутствуют эффективные отражатели.

Заметим в заключение, что проведенный выше анализ остается в силе, когда осцилляция сообщается движущемуся или неподвижному электронному сгустку бегущей электромагнитной волной накачки.

ЛИТЕРАТУРА

 Ковалев Н. Ф., Петелин М. И. // Релятивистская высокочастотная электроника. Горький, 1981. Вып. 2. С. 63. [2] Тап g C. M., Sprangle P. // Phys. of Quant. Electr. V. 9: Free-Electron Generators of Coherent Radiation. Addison — Wesley, 1982. Р. 849. [3] Афонин А. М., Канавец В. И., Черепенин В. А.// Лурацитехн. и электроника. 1980. 25, № 9. С. 1945. [4] Канавец В. И., Корженевский А. В., Черепенин В. А.// Радиотехн и электроника. 1985. 30, № 11. С. 2202.
[5] Черепенин В. А.// Генераторы и усилители на релятивистских электронных потоках. М., 1987. С. 76. [6] Кондратенко А. М., Салдин Е. А.//ЖТФ. 1981.
51, № 8. С. 1633. [7] Ginzburg N. S., Kovalev N. F., Rusov N. Yu.//Opt. Commun. 1985. 52, № 1. Р. 46. [10] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф.// Письма в ЖТФ. 1987. 13, № 5. С. 234. [11] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф.// Письма в ЖТФ. 1987. 13, № 5. С. 234. [11] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф.// Письма в ЖТФ. 1987. 13, № 5. С. 234. [11] Гинзбург Н. С., Сергеев А. С.//ЖТФ. 1989. 59, № 3. С. 126; ЖТФ. 1990. 61. № 8. С. 40. [12] Гинзбург Н. С., Сергее в А. С.//КТФ. 1980. 1989. 15, № 10. С. 78. [13] Ginzburg N. S., Gorshkova M. A., Sergeev A. S.//Opt. Commun. 1990. 76, № 1. Р. 69. [114] Гинзбург Н. С. // Письма в ЖТФ. 1989. 15, № 11. С. 1274. [15] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Сергеев А. С.// Письма в ЖТФ. 1989. 1989. 15, № 11. С. 1274. [15] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Сергеев А. С.// Письма в ЖТФ. 1989. 16, № 18. С. 33. [16] Карбушев Н. И., // Шаткус А. Д.//Письма в ЖТФ. 1989. 99, № 11. С. 1274. [15] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Сергеев А. С.// Письма в ЖТФ. 1989. 99, № 14. С. 594. [17] Карбушев Н. И., // Письма в ЖТФ. 1989. 15, № 24. С. 93. [18] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Сергеев А. С.// Письма в ЖТФ. 1989. 99, № 14. С. 594. [17] Карбушев Н. И. // Письма в ЖТФ. 1989. 15, № 24. С. 93. [18] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Сергеев А. С.// Дисьма в ЖТФ. 1989. 99, № 14. С. 594. [17] Карбушев Н. И. // Письма в ЖТФ. 1989. 199. 16, № 18. С. 504. [19] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф., Петелин М. И.///Емятивистская выскочастогная электроника. Горький, 1991. Вып. 6. С. 7. [20] Канавец В. И., Стабинис А. Ю.//Вести. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1973. 14, № 2. С. 186. [21] Железняков В. В., Кочаровский В. В.// Письма в ЖТФ. 1989. 15, № 14. С. 83. [22] Гинзбург Н. С., Сергеев А. С.// ЖитФ. 1989. 15, № 14. //Радиотехн. и электроника. 1980. 25, № 9. С. 1945. [4] Канавец В. И., Корженевский А. В., Черепенин В. А. // Радиотехн и электроника. 1985. 30, № 11. С. 2202. скан Б. Б., Кочаровскан Бл. Б. // лотФ. 1904. 54, № 5. С. 1505. [34] Анд-реев А. В., Емельянов В. И., Ильинский Ю. А. // Кооперативные явления в оптике. М., 1988. [35] Братман В. Л., Гинзбург Н. С., Петелин М. И. // //ЖЭТФ. 1979. 76, № 3. С. 938. [36] Гинзбург Н. С. // Письма в ЖТФ. 1984. 16, № 10. С. 584. [37] Kroll N. M., Morton P. L., Rosenbluth M. N. // IEEE J. Quant. Electron. 1981. QE-17, N 8. P. 1436.